

製品概要

AFGHL50T65SQDC: ハイブリッドIGBT - SiC-SBDを搭載した650V、50Aフィールドストップ4トレンチ IGBT

技術情報は、データシートをご参照ください。

新しいフィールドストップIGBTとSiC SBD技術を使用した、オン・セミコンダクターの新シリーズのハイブリッドIGBTは、ハードスイッチング・アプリケーションに最適な性能を提供します。このデバイスは、シリコンベースのIGBTとSiCショットキバリアダイオードを1パッケージ化しており、性能の低いシリコンベースのソリューションと、コストの高い完全なSiCベースのソリューションとの間の優れたトレードオフを実現します。

特長

- Copacked with SiC schottky barrier diode
- Maximum Junction Temperature, $T_j=175^{\circ}\text{C}$
- Automotive Qualified
- Very low switching and conduction losses
- Positive temperature co-efficient
- 100% of the parts are dynamically tested
- Tight parameter distribution

アプリケーション

- Automotive
- Industrial Inverter
- DC-DC Converter
- PFC, Totem Pole Bridgeless
- Hard Switching

利点

- Ultra low reverse recovery loss
- Higher reliability

最終製品

- xEV On & Off board charger
- UPS
- Solar Inverter
- HVAC

電気的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	$V_{(BR)CES}$ Typ (V)	I_C Max (A)	$V_{CE(sat)}$ Typ (V)	V_F Typ (V)	E_{off} Typ (mJ)	E_{on} Typ (mJ)	T_{rr} Typ (ns)	I_{rr} Typ (A)	Gate Charge Typ (nC)	Short Circuit Withstand (μs)	E_{AS} Typ (mJ)	P_D Max (W)	Co-Packaged Diode	Package Type
AFGHL50T65SQDC	5.9999	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free	Active	650	50	1.6	1.45					94				Yes	TO-247-3LD

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

6/25/2021 作成